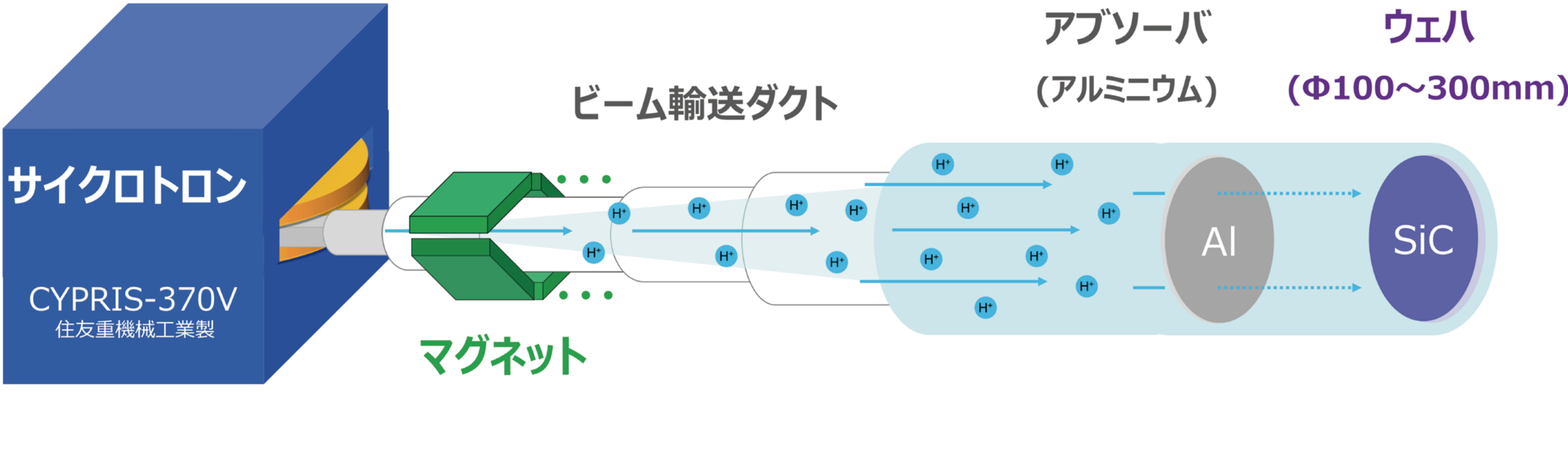
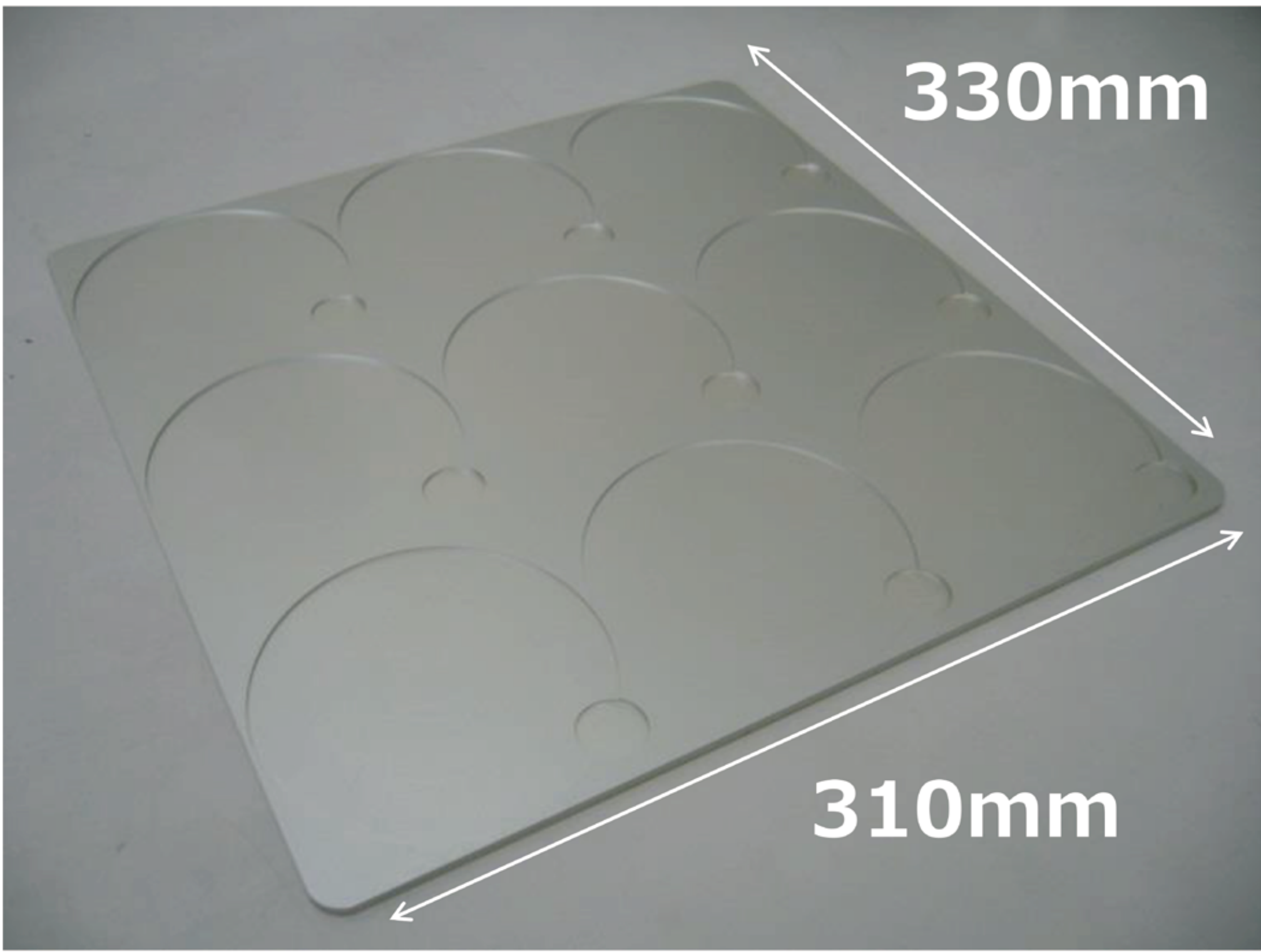
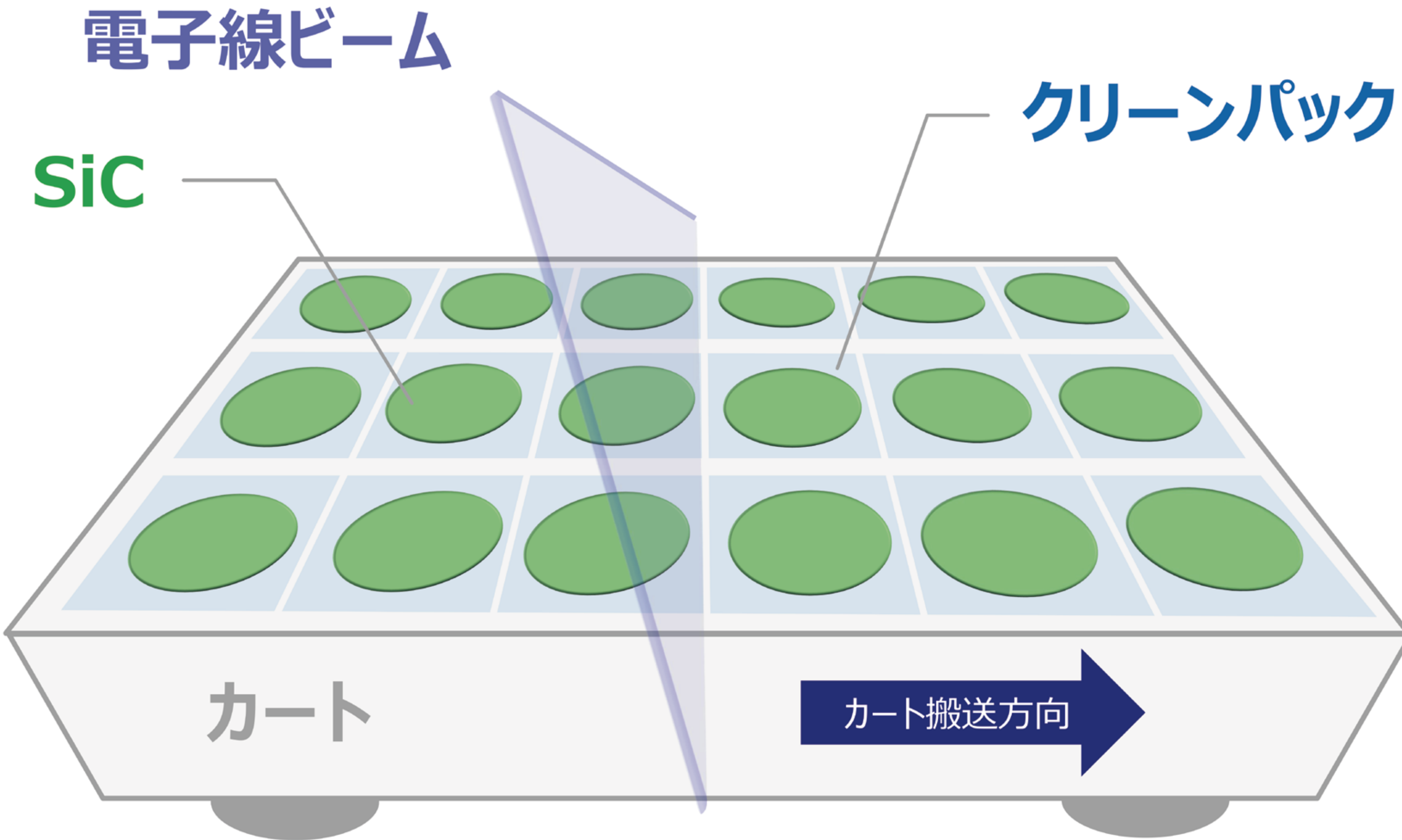


高エネルギーイオン注入サービス



サイクロトロン 仕様表	ガス	イオン	エネルギー	SiC中深さ (μm)	FWHM (μm)
	水素	H^+	2MeV	0~29	1
		H^+	4MeV	0~113	4
		H^+	8MeV	0~320	11
	ヘリウム-3	$^3\text{He}^{2+}$	23MeV	0~229	4
タンデム 仕様表	ヘリウム-4	$^4\text{He}^{2+}$	17MeV	0~114	2
	水素	H^+	0.26~2.40MeV	1.6~43.0	~1.7
	ヘリウム-4	$^4\text{He}^+$	0.26~2.40MeV	0.8~5.9	~0.2

高エネルギー電子線照射サービス



電子線照射 仕様表	拠点	エネルギー	1回あたり 照射量	1日あたり 最大照射量	照射可能な 最大サンプルサイズ	カート 台数
	つくば	2.0MeV	$3.1\text{E}13\text{cm}^{-2}$	$7.8\text{E}14\text{cm}^{-2}$	1,000×1,500mm	24台
	大阪	4.6MeV	$6.3\text{E}13\text{cm}^{-2}$	$1.6\text{E}15\text{cm}^{-2}$	1,000×1,500mm	37台